	<h2 style="color: #E67E22;">FDA16N50-F109</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDA16N50-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P
	Datenblätter:  FDA16N50-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 314 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


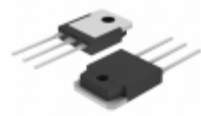






Spezifikationen

Teilenummer	FDA16N50-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	314 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 8.3A, 10V
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FDA16N50_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1945pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 16.5A (Tc) 205W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)

FDA16N50-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA16N50-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA16N50-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDA16N50-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDA18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 19A TO-3P</p>	 <p>FDA16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P</p>	 <p>FDA15N65 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 16A TO-3PN</p>	 <p>FDA15N65 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 16A TO-3PN</p>
 <p>FDA16N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P</p>	 <p>FDA16N50LDTU FSC FSC TO-3P</p>	 <p>FDA16N50LDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor UNIFET N-CHANNEL 500V MOSFET LDT</p>	 <p>FDA1254-H-4R7M=P3 Murata Electronics FIXED IND 4.7UH 10.2A 8.8 MOHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDA16N50-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA16N50-F109-Datenblatt	FDA16N50-F109-Datenblätter	FDA16N50-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA16N50-F109
FDA16N50-F109 Electronic	FDA16N50-F109-Komponenten	FDA16N50-F109-Verteiler	FDA16N50-F109-Bild	FDA16N50-F109-Teil
FDA16N50-F109 Preis	FDA16N50-F109 Hersteller	FDA16N50-F109 Bild	FDA16N50-F109 Aktie	FDA16N50-F109 Inventar
FDA16N50-F109 Neu	FDA16N50-F109 Original	FDA16N50-F109 garantiert	FDA16N50-F109 RFQ	FDA16N50-F109 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited